

低エネルギーイオンビーム技術を用いた 各種材料の成膜方法の開発

#低エネルギーイオンビーム成膜

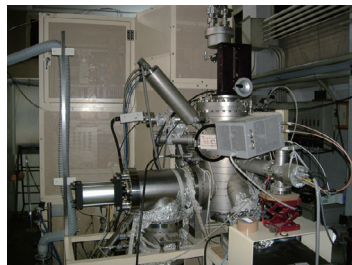
#化合物半導体

#絶縁膜

#金属膜

研究
内容

当研究グループでは、低エネルギーイオンビーム技術を用いた様々な研究テーマに取り組んでいます。近年は、主に各種材料の成膜実験に取り組んでいます。これまでに、化合物半導体（炭化ケイ素など）、絶縁膜（酸化ケイ素）、金属膜（錫など）の成膜に成功しております。原料には、シランのような危険なものは用いずに、安全かつ安価な原料を利用した成膜法の開発を行っています。そのほかに、イオンビーム技術およびアークプラズマ技術を用いた、新しい触媒合成技術の開発にも取り組んでいます。



Develop+
応用分野

ヘテロエピ成長、質量分析



吉村 智 YOSHIMURA Satoru

マテリアル生産科学専攻
附属アトミックデザイン研究センター 准教授
生産プロセス講座 エネルギー形態制御領域
浜口研究室



論文・解説など

- [1] S. Yoshimura et al., *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*, Vol. 549, 165276 (2024).
- [2] S. Yoshimura et al., *AIP Advances*, Vol. 13, No. 11, 115107 (2023).
- [3] S. Yoshimura et al., *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, Vol. 1056, 168707 (2023).

連絡先HP

